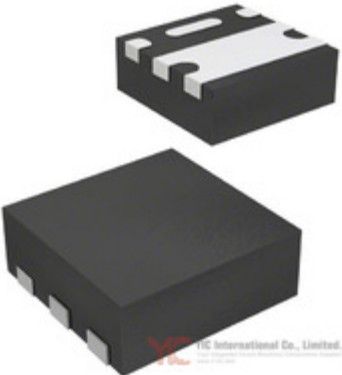

	<p>SIA438EDJ-T1-GE3</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SIA438EDJ-T1-GE3</p>
	<p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 20V 6A PPAK SC70-6L</p>
	<p>Datenblätter:  SIA438EDJ-T1-GE3.pdf</p>
	<p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>


Spezifikationen

Teilenummer	SIA438EDJ-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 20V 6A PPAK SC70-6L
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1.4V @ 250µA
Vgs (Max)	±12V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SC-70-6 Single
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	46 mOhm @ 3.9A, 4.5V
Verlustleistung (max)	2.4W (Ta), 11.4W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SC-70-6
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	15 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	350pF @ 10V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	12nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	2.5V, 4.5V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 20V 6A (Tc) 2.4W (Ta), 11.4W (Tc) Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	6A (Tc)

SIA438EDJ-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIA438EDJ-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIA438EDJ-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SIA438EDJ-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SIA440DJ-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 40V 12A SC-70</p>	 <p>SIA436DJ-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 8V 12A SC70-6L</p>	 <p>SIA437DJ-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 20V 29.7A SC70-6</p>	 <p>SIA439EDJ-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 20V 28A SC-70-6L</p>
 <p>SIA439EDJ-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 28A SC-70-6L</p>	 <p>SIA440DJ-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 40V 12A SC-70</p>	 <p>SIA437DJ-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 29.7A SC70-6</p>	 <p>SIA436DJ-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 8V 12A SC70-6L</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SIA438EDJ-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay	SIA438EDJ-T1-GE3 Datenblatt	SIA438EDJ-T1-GE3-Datenblätter	SIA438EDJ-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SIA438EDJ-T1-GE3
SIA438EDJ-T1-GE3 Electronic	SIA438EDJ-T1-GE3-Komponenten	SIA438EDJ-T1-GE3-Verteiler	SIA438EDJ-T1-GE3-Bild	SIA438EDJ-T1-GE3-Teil
SIA438EDJ-T1-GE3 Preis	SIA438EDJ-T1-GE3 Hersteller	SIA438EDJ-T1-GE3 Bild	SIA438EDJ-T1-GE3 Aktie	SIA438EDJ-T1-GE3 Inventar
SIA438EDJ-T1-GE3 Neu	SIA438EDJ-T1-GE3 Original	SIA438EDJ-T1-GE3 garantiert	SIA438EDJ-T1-GE3 RFQ	SIA438EDJ-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited